
	<h2 style="color: red;">FQD2N60CTM</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD2N60CTM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD2N60CTM.pdf</a> <a href="#">2.FQD2N60CTM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 19898 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N60CTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	19898 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	1.9A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 Ohm @ 950mA, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	235pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD2N60CTM ist neu im Original, Suche FQD2N60CTM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD2N60CTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD2N60CTM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FQD2N60CTM_WS</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A	 <b>FQD2N60TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A DPAK	 <b>FQD2N60CTM-WS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A	 <b>FQD2N60TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A DPAK
 <b>FQD2N60CTF_F080</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK	 <b>FQD2N60TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A DPAK	 <b>FQD2N60CTF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK	 <b>FQD2N60CTF-NL</b> Fairchild/ON Semiconductor FQD2N60CTF-NL FAIRCHILD

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQD24N08	↔ FQD24N08TF	⇒ FQD24N08TF	D FQD24N08TM	⇒ FQD24N08TM
⊣ FQD2N100	⊗ FQD2N100TM	D FQD2N100TM	⇒ FQD2N30TF	⇒ FQD2N40TM
⊗ FQD2N40TM	⊣ FQD2N50B	⊗ FQD2N50C	↔ FQD2N50TF	⇒ FQD2N50TF
D FQD2N50TM	⊗ FQD2N50TM	⊣ FQD2N60A	⊗ FQD2N60C	⇒ FQD2N60CTF
⇒ FQD2N60CTF	↔ FQD2N60CTF-NL	⊗ FQD2N60CTF_F080	⊣ FQD2N60CTF_F080	⇒ FQD2N60CTM
↔ FQD2N60TM	⇒ FQD2N60TM	D FQD2N65C	⊗ FQD2N80TM	⊣ FQD2N80TM
⊗ FQD2N80TM-NL	D FQD2N90TF	⇒ FQD2N90TF	↔ FQD2P25TF	⇒ FQD2P25TM
⊣ FQD30N06	⊗ FQD30N06L	↔ FQD30N06LTF	⇒ FQD30N06LTF	⇒ FQD30N06LTM
⊗ FQD30N06LTM	⊣ FQD30N06TF	⊗ FQD30N06TF	D FQD30N06TF_F080	⇒ FQD30N06TF_F080
↔ FQD30N06TM	⊗ FQD30N06TM	⊣ FQD30P06	⊗ FQD3N25T	⇒ FQD3N30TF

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited